

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЙ
СОСТАВНОЙ ТРАНЗИСТОР С ИНТЕГРАЛЬНЫМИ
ДЕМПФИРУЮЩИМ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ ДИОДАМИ**

АДБК.432140.818 ТУ

ИСО 9001-2001

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В СХЕМАХ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, УЗЛАХ И БЛОКАХ АППАРАТУРЫ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- * Рабочий температурный диапазон: - 45°C ÷ +125°C
- * Зарубежный аналог - **BU941ZP**
- * Изготавливается в корпусе **КТ-43 (ТО-218)**.



ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. изм.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо max	В	350
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max	А	15
Импульсный ток коллектора	Iки max	А	30
Постоянный ток базы	Iб max	А	1
Импульсный ток базы	Iби max	А	5
Рассеиваемая мощность коллектора:	Рк max	Вт	155
Температура перехода	Tj	°С	175
Тепловое сопротивление переход-корпус	Rt пер-кор	°С/Вт	0.97

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обознач.	Ед, измер	Режим измерения	Мин	Макс
Обратный ток коллектор-эмиттер	Iкэо	мА	Uкэ=300В, Iб=0		0.1
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мА	Uэб= 5В, Iк=0		20
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер (1)	Uкэ (нас)	В	Iк=8А, Iб=100мА		1.8
			Iк=10А, Iб=250мА		1.8
			Iк=12А, Iб=300мА		2.0
Напряжение насыщения база-эмиттер(1)	Uбэ (нас)	В	Iк=8А, Iб=100мА		2.2
			Iк=10А, Iб=250мА		2.5
			Iк=12А, Iб=300мА		2.7
Статический коэффициент передачи тока (1,2)	h21Э		Uкэ=10В, Iк=5А	300	
Граничное напряжение коллектор - эмиттер	Uкэо гр	В	Iк=100мА, Iб=0 tu ≤300 мкс, Q ≥100	350	500
Прямое напряжение на диоде	Uпр.д	В	Iэ=10А		2.5
Время: рассасывания спада	трас. * тсп. *	мкс	Iк=7А, Uкэ=300В, Iб1= Iб2=70мА	типов.	15
					0.5
Импульсная энергия на индуктивной нагрузке	Еимп.*	мДж	Iк=10А, Uк=24В, L=7мГн	350	

- * - Справочные параметры, (1) Импульсный режим: tu ≤300 мкс, Q ≥50,
- (2) Режим измерения для схемы с общей базой: Uкб= 7.5В, Iэ=Iк

